

2SB1076M 2SB1239

エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコンダーリントントランジスタ
低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.
Epitaxial Planar PNP Silicon Darlington Transistors

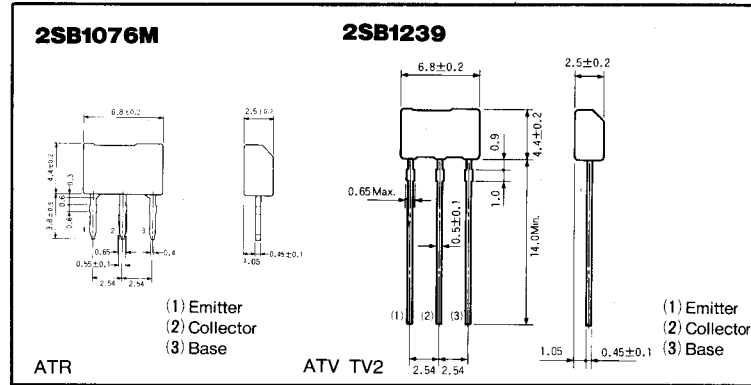
● 特長

- 1) ダーリントン接続で高 h_{FE} である。
- 2) BE間に約4k Ω の抵抗を内蔵。温度安定性が良い。

● Features

- 1) Darlington connection provides high DC current gain (h_{FE}).
- 2) Built-in resistance of approx. 4k Ω across base and emitter. Excellent temperature stability.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



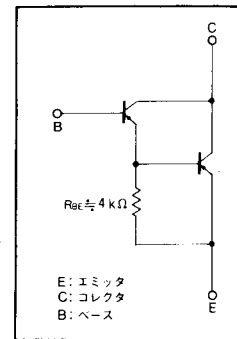
注：ATVの外形仕様については、TV3/4/6タイプも用意しています (p.38参照)。

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	-40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CER}	-40	V (R _{BE} =10k Ω)
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I _C	-2	A
コレクタ損失	P _C	1	W*
接合部温度	T _J	150	°C
保存温度範囲	T _{stg}	-55~150	°C

* プリント基板：
コレクタ部分の
銅箔面積1cm²
以上、厚み1.7
mm

● 内部等価回路図



● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CER}	-40	-	-	V	I _C = -1mA, R _{BE} = 10k Ω
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CB0}	-40	-	-	V	I _C = 50 μ A
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EBO}	-5	-	-	V	I _E = -50 μ A
コレクタシャ断電流	I _{CB0}	-	-	-1	μ A	V _{CB} = -24V
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	-	-	-1	μ A	V _{EB} = -4V
エレクト・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	-	-0.80	-1.5	V	I _C /I _B = -0.6A/-1.2mA
直流電流増幅率	h _{FE}	1 000	-	-	-	V _{CE} / I _C = -3V/-0.5A
利得帯域幅積	f _T	-	150	-	MHz	V _{CE} = -6V, I _E = 0.1A
出力容量	C _{ob}	-	11	-	pF	V _{CB} = -10V, I _E = 0A, f = 1MHz

● 標準品・準標準品一覧表

(◎: 標準品 ○: 準標準品)

Type	h _{FE}	包装名 記号 基本発注単位(個)	バルク		コンテナ		テーピング	
			1 000	4 000	C2	TV2	TV3	TV3
2SB1076M	A (1 000以上)		◎	○	-	-	-	-
2SB1239	A (1 000以上)		-	-	◎	○	-	-